

遅延溶断型 表面実装 マイクロヒューズ
KAB型Sシリーズ (1608サイズ)

Rosh対応、UL取得予定

新商品

■ 特徴

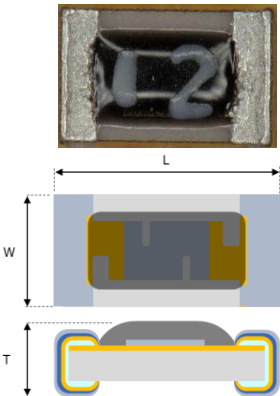
DDR4やDDR5の高周波・高電流動作への対応として1608サイズの遅延溶断品を開発しました。

■ アプリケーション

SSD、メモリ関連、PC関連 等

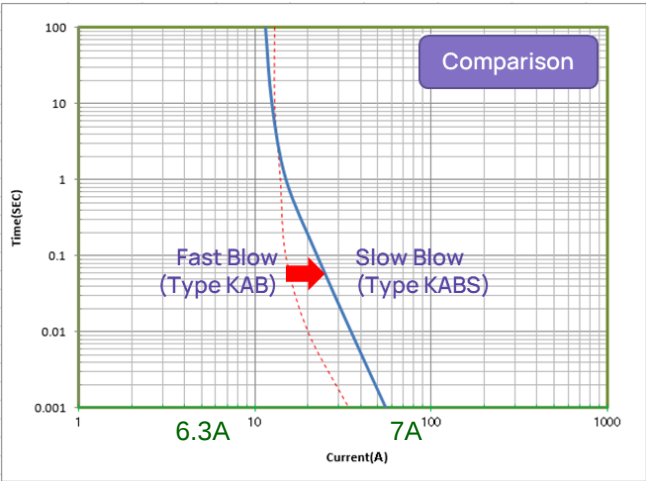
■ 製品寸法

Case Code	EIA Code	L±0.1	W±0.1	T Max.
29	1608	1.6	0.8	0.45



■ 既存品との溶断特性比較

溶断特性 100%：4時間以上
200%：1～120秒以内



■ 仕様

項目	定格
ケースサイズ	1.6 mm × 0.8 mm
使用温度範囲	-40 ～ +125 °C
定格電圧	32 VDC
(1)絶縁抵抗	1 MΩ
通電容量	定格電流を通電した場合に4 時間以内に溶断しない
遮断特性	定格 2A～5A：75 VDC：50 A 定格 6.3A～7A：32 VDC：50 A
定格電流	2A, 2.5A, 3.15A, 4A, 5A, 6.3A, 7A
電圧降下	110 mV Max
(2)溶断特性	定格電流の 200%の電流を通電した場合に 120 秒以内に溶断すること 定格電流の 200%の電流を通電した場合に 1 秒以上溶断しないこと 定格電流の 300%の電流を通電した場合に 3 秒以内に溶断すること

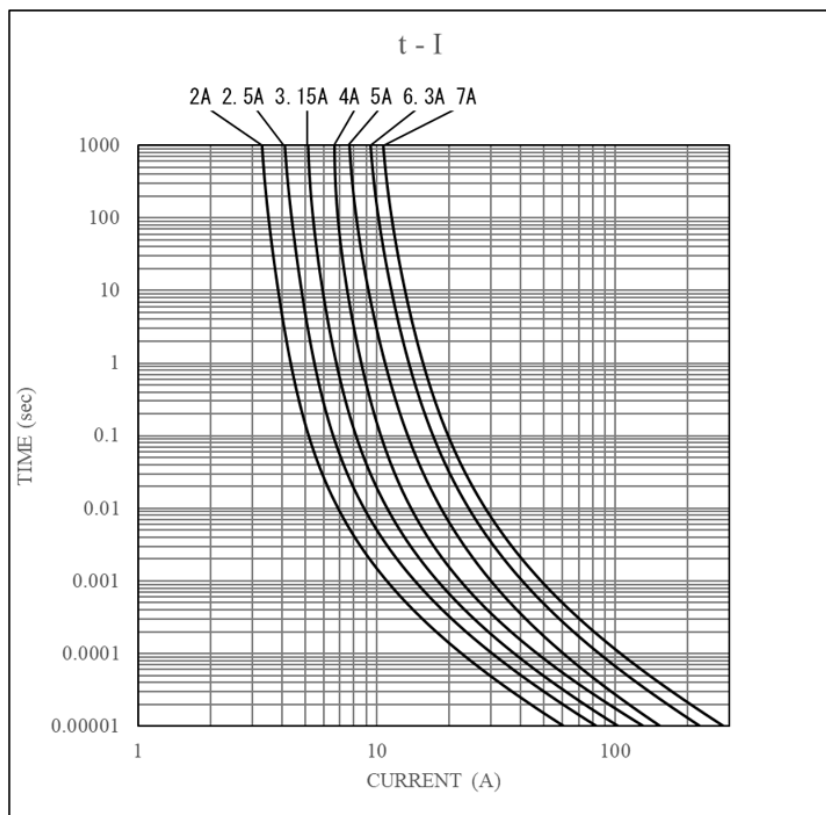
- (1) 電極端子と外装間の抵抗値を定格電圧以下で測定した場合。
(2) 周囲温度 10℃～30℃で試験用標準基板を用いた場合。

Note)
内容は変更の可能性があります。
正式には納入仕様書をご要求下さい。



遅延溶断型 表面実装 マイクロヒューズ KAB型Sシリーズ (1608サイズ)

■ 溶断特性



■ 標準品一覧

形名	定格電流 A	(1) 電気抵抗 <u>mΩ</u> 参考値	電圧降下 mV Max	定格電圧 VDC	定格 遮断容量 A
KABS7502202 NA29	2	85.0	110	75	50
KABS7502252 NA29	2.5	55.0	110	75	50
KABS7502322 NA29	3.15	40.0	110	75	50
KABS7502402 NA29	4	26.0	110	75	50
KABS7502502 NA29	5	19.0	110	75	50
KABS3202632 NA29	6.3	12.8	110	32	50
KABS3202702 NA29	7	10.2	200	32	50

Note)
内容は変更の可能性がございます。
正式には納入仕様書をご要求下さい。



MATSUO ELECTRIC CO., LTD.

ES30-25-002